

Содержание

● Неэлектронные свойства полупроводников (атомная структура, диффузия)

Когай В.Я., Михеев Г.М.

Твердофазные реакции и фазовые превращения в наноразмерной пленочной структуре висмут/селен 823

Привезенцев В.В., Кириленко Е.П., Горячев А.В., Лютцау А.В.

Формирование преципитатов в Si, имплантированном ионами $^{64}\text{Zn}^+$ и $^{16}\text{O}^+$ 827

Матухин В.Л., Погорельцев А.И., Гавриленко А.Н., Гарькавый С.О., Шмидт Е.В., Бабаева С.Ф., Суханова А.А., Теруков Е.И.

Особенности спектров ЯМР $^{63,65}\text{Cu}$ в локальном поле образцов полупроводникового минерала CuFeS_2 из сульфидных месторождений океана 836

● Электронные свойства полупроводников

Грушка О.Г., Чупыра С.М., Биличук С.В., Парфенюк О.А.

Электронные процессы в кристаллах CdIn_2Te_4 840

Аванесян В.Т., Ракина А.В., Каблукова Н.С.

Оптическое поглощение поликристаллических слоев сульфида цинка, активированного медью 844

Вейнгер А.И., Кочман И.В., Окулов В.И., Андрийчук М.Д., Паранчич Л.Д.

Осцилляции микроволнового магнитопоглощения в кристаллах HgSe с примесью Fe 847

● Поверхность, границы раздела, тонкие пленки

Роках А.Г., Шишкин М.И., Аткин В.С.

О рекомбинационных процессах в пленках CdS-PbS . . . 853

Лунин Л.С., Лунина М.Л., Кравцов А.А., Сысов И.А., Блинов А.В., Пашенко А.С.

Влияние концентрации наночастиц серебра в функциональных покрытиях $\text{TiO}_2\text{-Ag}$ на характеристики фотопреобразователей GaInP/GaAs/Ge 860

● Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

Кулагина А.С., Евстропьев С.К., Розанов Н.Н., Влазов В.В.

Нелинейно-оптические свойства квантовых точек CdS/ZnS в матрице из высокомолекулярного поливинилпирролидона 865

Яковлев Г.Е., Дорохин М.В., Зубков В.И., Дудин А.Л., Здравейцев А.В., Малышева Е.И., Данилов Ю.А., Звонков Б.Н., Кудрин А.В.

Особенности электрохимического вольт-фарадного профилирования арсенид-галлиевых светоизлучающих и рНЕМТ-структур с квантово-размерными областями 873

Середин П.В., Голощапов Д.Л., Золотухин Д.С., Леньшин А.С., Лукин А.Н., Худяков Ю.Ю., Арсентьев И.Н., Жаботинский А.В., Николаев Д.Н., Пихтин Н.А.

Влияние разориентации подложки и ее предварительного травления на структурные и оптические свойства интегрированных гетероструктур GaAs/Si(100) , полученных методом газовой фазной эпитаксии 881

Смагин В.П., Еремина Н.С., Леонов М.С.

Фотолюминесценция ZnS:Cu в матрице полиметилметакрилата 891

Зайнабидинов С., Турсунов И.Г., Химматкулов О.

Влияние изотропного давления на вольт-амперную характеристику поверхностно-барьерных диодов Sb-p-Si(Mn)-Au 896

Векслер М.И.

Моделирование туннельного переноса электронов в системе полупроводник—кристаллический диэлектрик— Si(111) 900

Михайлова М.П., Андреев И.А., Коновалов Г.Г., Данилов Л.В., Иванов Э.В., Куницына Е.В., Ильинская Н.Д., Левин Р.В., Пушный Б.В., Яковлев Ю.П.

Эффект увеличения фотопроводимости в гетероструктуре II типа $n\text{-GaSb/InAs/p-GaSb}$ с одиночной квантовой ямой 906

● Аморфные, стеклообразные, органические полупроводники

Кастро Р.А., Анисимова Н.И., Кононов А.А.

Диэлектрическая релаксация в тонких слоях стеклообразной системы $\text{Ge}_{28.5}\text{Pb}_{15}\text{S}_{56.5}$ 912

● Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники

Джафарова В.Н., Оруджев Г.С., Гусейнова С.С., Стемпицкий В.Р., Баранова М.С.

Магнитные свойства вакансий и внедренного хрома в кристалле ZnO 916

Елистратова М.А., Полоскин Д.С., Горячев Д.Н., Захарова И.Б., Сресели О.М.

Динамика изменения фотолюминесценции пористого кремния после гамма-облучения 921

Петросян П.Г., Григорян Л.Н., Мусаелян Г.А.

Применения силикатных стекол с полупроводниковыми нанокристаллами $\text{CdS}_x\text{Se}_{1-x}$ в качестве оптических термометров и оптических фильтров с регулируемым краем поглощения 926

**Романов Н.М., Елистратова М.А., Lahderanta E.,
Захарова И.Б.**

Деградация фотолюминесценции тонких пленок ZnTPP
и ZnTPP—C₆₀ под действием гамма-облучения 931

● **Физика полупроводниковых приборов**

Шалимова М.Б.

Модуляция заряда германиевых МДП-структур с фторсо-
держащими диэлектриками 939

Ионычев В.К., Шестеркина А.А.

Влияние глубоких центров на статистическую задержку
микроплазменного пробоя в арсенид-галлиевых светодио-
дах 944

**Васильева Г.Ю., Васильев Ю.Б., Новиков С.Н., Да-
нилов С.Н., Ганичев С.Д.**

Изготовление *p*–*n*-переходов в графене и их применение
для детектирования терагерцового излучения 949

**Бабичев А.В., Гладышев А.Г., Курочкин А.С., Ко-
лодезный Е.С., Соколовский Г.С., Бугров В.Е., Ка-
рачинский Л.Я., Новиков И.И., Bousseksou A., Его-
ров А.Ю.**

Лазерная генерация многопериодных квантово-каскадных
лазеров на длине волны излучения 8 мкм при комнатной
температуре 954

● **Изготовление, обработка, тестирование материалов
и структур**

Боднарь И.В., Тхан Чан Бинь

Кристаллическая структура и ширина запрещенной зоны
твердых растворов (MnIn₂S₄)_{1–x} · (AgIn₅S₈)_x 958